mgr inż. Piotr Frydrych<sup>1)</sup>, prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk<sup>2)</sup>, dr inż. Jacek Salach<sup>1)</sup>, mgr inż. Krzysztof Trzcinka<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej

<sup>2)</sup> Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

# Miniaturowe, dwuosiowe czujniki pola magnetycznego z rdzeniami z magnetyków amorficznych

W artykule przedstawiono koncepcję budowy dwuosiowych, transduktorowych czujników pola magnetycznego z rdzeniami z taśmy amorficznej. Jednocześnie przedstawiono nowatorską metodę kształtowania i badania charakterystyk magnesowania rdzeni ramkowych z taśmy amorficznej, wykorzystywanych jako rdzenie badanych czujników. Metoda ta umożliwia pomiar anizotropii magnetycznej rdzenia. Informacja o wartości anizotropii jest niezbędna przy budowie czujników dwuosiowych, a opisane do tej pory metody nie umożliwiały tego typu pomiarów.

#### MINIATURIZED, TWO AXIS MAGNETIC FIELD SENSORS WITH AMORPHOUS ALLOY CORES

Paper presents new conception of two-axis, fluxgate magnetic field sensors for measurements of Earth's magnetic field. Developed sensors utilizes soft amorphous alloys. Moreover paper presents new methodology of shaping and testing of magnetic characteristics of frame-shaped amorphous alloys cores utilized in such sensors. Presented methodology of testing enables direct measurements of magnetic anisotropy of amorphous alloy, what is required for development of two-axis fluxgate sensors.

#### **1. WPROWADZENIE**

Pierwsze w historii, praktyczne wykorzystanie pom iarów ziem skiego pola m agnetycznego zostało opisane w ksi ążce Zhu Yu "Rozm owy przy stole w Pingzhou" wydanej w 1119 roku w Chinach. Od tego czasu czujniki do detekcji i pom iaru pola m agnetycznego są przedmiotem ciągłych badań i prac rozwojowych. Jednak do tej pory wielu zagadnień technicznych nie udało się ostatecznie rozwiązać.

Szczególnie wa żnym obszarem rozwoju czujników do pom iaru pola m agnetycznego s ą miniaturowe czujniki do pom iaru pól m agnetycznych o nat ężeniu do oko ło 100 A/m, w szczególności ziem skiego pola m agnetycznego. Pom iary tego pola m ają zasadnicze znaczenie w pom iarach geodezyjnych [1], nawigacyjnych [2] oraz pom iarach na potrzeby systemów bezpiecze ństwa publicznego, szczególnie detekcji m etalowych elem entów urz ądzeń pirotechnicznych [3].

Z technicznego punktu widzenia, do pom iaru pola m agnetycznego w zakresie do 100 A/m mogą by ć wykorzystywane czujniki m agnetorezystancyjne [4], czujniki typu SQUID [5], czujniki optomagnetyczne [6] i czujniki transduktorowe [7]. Jednak m ożliwości zastosowania czujników SQUID i czujników optomagnetycznych w systemach na potrzeby bezpieczeństwa publicznego s ą bardzo ograniczone, ze wzgl ędu na ich znaczn ą ma sę oraz, w przypadku czujników SQUID, konieczno ści zapewnienia m ożliwości pracy nadprzewodnikowego elementu sensorowego w temperaturze 4 K (ciekłego helu). Dlatego w systemach na potrzeby

bezpieczeństwa publicznego są wykorzystywane czujniki magnetorezystancyjne i transduktorowe. Jednak czujniki magnetorezystancyjne, ze względu na konieczność zastosowania cewek ortogonalnych wytwarzających pole magnetyczne o znacznym natężeniu [8], są dość energochłonne. Szczególnie jest to niekorzystne w przypadku system ów mobilnych. Powoduje to konieczność dalszego rozwoju czujników transduktorowych, w szczególności w zakresie ich miniaturyzacji i doskonalenia technologii wytwarzania rdzeni stosowanych do ich budowy.

W referacie przedstawiono now a koncepcj ę budowy m iniaturowych, grubowarstwowych czujników transduktorowych, z rdzeniam i ze stopów am orficznych, um ożliwiających dwuosiowy pomiar pola m agnetycznego. Do tej pory tego typu czujniki um ożliwiały wyłącznie jednoosiowy pomiar pola m agnetycznego [9]. Barier ą w opracowaniu dwuosiowych czujników transduktorowych był brak m ożliwości pomiaru charakterystyk m agnetycznych magnetyków amorficznych w kierunku prostopadłym do kierunku taśmy. W referacie przedstawiono także tak ą me todę, co otworzy ło m ożliwość opracowania czujników dwuosiowych, nie prezentowanych do tej pory w literaturze światowej.

## 2. WYTWARZANIE MINIATUROWYCH RDZENI RAMKOWYCH Z TAŚM AMORFICZNYCH

Amorficzne stopy ultraszybkoch łodzone uzyskiwane s ą w form ie ta śm o grubo ści oko ło 25 µm [10]. Ta śmy te cechuj ą się znaczną twardością i krucho ścią, co ogranicza m ożliwość wycinania kształtek rdzeni, w szczególno ści na skal ę przemysłową. Z tego wzgl ędu w opracowanej technologii produkcji kszta łtek rdzeni opracowywanych grubowarstwowych czujników transduktorowych zastosowano m etodę fotolitograficzną. W ygląd m atrycy do fotolitograficznej produkcji rdzeni czujników transduktorowych przedstawiono na rys. 1.





W procesie produkcji rdzeni ram kowych, taśmy ze stopu am orficznego o składzie Fe<sub>78</sub>Si<sub>13</sub>B<sub>9</sub> (Metglas 2605 wyprodukowanego przez firm ę Hitachi Metals) o szeroko ści ta śmy 28 mm pokryto z jednej strony lakierem, a z drugiej strony warstw ą światłoczułą Positiv20. Nast ępnie warstw ę światłoczułą na świetlono prom ieniowaniem UV przez m atrycę przedstawion ą na rys. 1. W kolejnej fazie, ta śmy ze stopu am orficznego wytrawiono w roztworze nadsiarczanu sodowego, utrzym ywanego w stabilizowanej tem peraturze 55 °C. Nast ępnie, po wypłukaniu, zb ędne warstwy światłoczułe i lakierowe zosta ły zm yte rozpuszczalnikiem typu nitro.

Opracowana m etoda um ożliwia swobodne kszta łtowanie rdzeni z ta śm am orficznych o zróżnicowanym składzie (zarówno stopów na bazie żelaza, jak i niklu oraz kobaltu). W łaściwy dobór param etrów technologicznych procesu wytrawiania um ożliwił uzyskanie g ładkich krawędzi produkowanych rdzeni, jak również wysoki stopień powtarzalności produkcji.

# 3. NOWA METODA BADAŃ ANIZOTROPII MAGNETYCZNEJ

Pomiar charakterystyk magnesowania taśm magnetycznych odbywa się dla rdzeni zwijanych. Metoda ta umożliwia jedynie pomiar charakterystyki magnesowania w kierunku taśmy, przez co nie ma możliwości pomiaru anizotropii magnetycznej rdzenia.

Pomiary charakterystyki m agnesowania rdzeni ram kowych trawionych z ta śmy am orficznej nie mogą być zrealizowane poprzez nawinięcie uzwojenia na rdzeń. Rdzeń z taśmy amorficznej jest zbyt wiotki. Dlatego konieczne jest um ieszczenie wytrawionego rdzenia wewn ątrz sześciowarstwowej płytki drukowanej i wykonie uzwojeń w formie ścieżek na płytce, tak jak to przedstawiono na rys. 2.



Rys. 2. Rdze ń ram kowy wraz z uzwojeniem w form ie ścieżek sze ściowarstwowej p łytki drukowanej: 1 - rdzeń ramkowy, 2 - uzwojenie pom iarowe w osi*Y*, <math>3 - uzwojenie pom iarowe w osi*X*, <math>4 - uzwojenie magnesujące

W opracowanym układzie pomiarowym uzwojenie magnesujące zasilano ze źródła prądowego typu BOP36 firm y Kepco sterowanego napi ęciem. Sterowanie napi ęciowe odbywało si ę z generatora funkcyjnego AFG3021B firm y Tectronics. Ze wzgl ędu na niewielki przekrój taśmy ze stopu am orficznego, sygnał indukowany na uzwojeniach pom iarowych jest s łaby. Dlatego w torze pom iarowym zastosowano dwa ultraszybkie, niskoszum ne wzm acniacze operacyjne OPA637 firm y Analog Devices. Nast ępnie, wzm ocnione sygna ły pom iarowe z uzwojeń pom iarowych w osiach X i Y oraz sygna ł napi ęciowy proporcjonalny do pr ądu sterującego transduktor podawano na oscyloskop cyfrowy i przesy lano do kom putera PC. W tym komputerze, w fazie analizy wyników pom iarów, realizowano całkowanie numeryczne, które umożliwiało wyznaczenie wartości indukcji magnetycznej w rdzeniu zarówno w osi X, jak i w osi Y. Błąd wyznaczenia warto ści indukcji pola m agnetycznego B oszacowano na 30% między innymi ze wzgl ędu na problem y z pom iarem grubości taśmy spowodowane jej niejednorodnością.

### 4. BUDOWA CZUJNIKA TRANSDUKTOROWEGO W TECHNOLOGII GRUBOWARSTWOWEJ

Na rys. 3 przedstawiono budow  $\notin$  m iniaturowego czujnika transduktorowego o wym iarach 35 mm x 35 mm x 1mm, umożliwiającego dwuosiowy pom iar pola m agnetycznego. Uzwojenie m agnesujące (2) w tym czujniku wykonano tak sam o jak uzwojenie m agnesujące w układzie przedstawionym na rys. 2. Natom iast uzwojenia pom iarowe (3) i (4) (uzwojenia wyjściowe czujnika transduktorowego) w osi X i w osi Y oplatają cały czujnik.



Rys. 3. Opracowany m iniaturowy, dwuosiowy czujnik transduktorowy: 1 - rdze ń czujnika, 2 - uzwojenie m agnesujące *Y*, 3 - uzwojenie pom iarowe w osi*X*, <math>4 - uzwojenie pom iarowe w osi*Y* 

W rezultacie działania pola mierzonego  $H_p$ , przebiegi indukcji w kolum nach rdzenia ramkowego odkształcają się niesymetrycznie. Dlatego w strumieniach magnetycznych  $\Psi_x(t)$  i  $\Psi_y(t)$  skojarzonych z uzwojeniam i pom iarowymi w osi X i osi Y (obejm ującymi obie kolum ny rdzenia ramkowego w danej osi) pojawia się składowa o częstotliwości dwa razy większej od częstotliwości przebiegu pr ądowego podawanego na uzwojenie steruj ące. W zakresie niewielkich, stałych pól m ierzonych  $H_p$ , amplituda tej drugiej harm onicznej jest proporcjonalna do mierzonego pola  $H_p$ . Zasada pracy przetwornika transduktorowego zosta ła opisana szczegółowo w pracach [11] i [12].

Przetwornik transduktorowy um ieszczono w cewkach Helm holtza um ożliwiających precyzyjne zadawanie wzorcowego pola m agnetycznego w zakresie do 100 A/m . Uzwojenie magnesujące czujnika zasilano ze źródła prądowego typu BOP36 firm y Kepco sterowanego napięciem. Sterowanie napięciowe odbywało się z generatora funkcyjnego AFG3021B firm y Tectronics. Natomiast w torze pom iarowym zastosowano precyzyjne wzm acniacze operacyjne OP27, zarówno dla toru pom iarowego w osi X jak i w osi Y. Zastosowanie ultraszybkich wzmacniaczy operacyjnych OPA637 nie by ło konieczne, poniewa ż sygna łem wyj ściowym z sensora jest druga harm oniczna prądowego przebiegu zasilaj ącego o cz ęstotliwości 1kHz. Filtrację i pom iar drugiej harm onicznej z przebiegu sygna łu wyjściowego z czujnika zrealizowano cyfrowo, po zarejestrowaniu tego sygnału na oscyloskopie cyfrowym.

### 5. WYNIKI BADAŃ CHARAKTERYSTYK RDZENIA AMORFICZNEGO ORAZ CZUJNIKA TRANSDUKTOROWEGO

Na rys. 5 przedstawiono p ętle histerezy m agnetycznej B(H) rdzenia ram kowego z ta śmy amorficznej ze stopu o sk ładzie Fe<sub>78</sub>Si<sub>13</sub>B<sub>9</sub> w stanie wyj ściowym (bez dodatkowej obróbki cieplnej) zmierzone przy cz ęstotliwości sinusoidalnie zmiennego natężenia pola m agnesującego równej 1200 Hz. Należy podkreślić, że pętle histerezy zarejestrowane w osi X i w osi Y mają zbliżony kształt. Jest to sprzeczne z powszechnie przyj ętym poglądem, że charakterystyki m agnesowania ta śmy am orficznej s ą znacz ąco różne w kierunku ta śmy i w kierunku prostopadłym do kierunku ta śmy [10]. Ewentualna silna anizotropowo ść ta śmy może by ć spowodowana przez naprężenia m echaniczne indukowane w trakcie procesu ultraszybkiego chłodzenia przy odlewaniu ta śmy. W takim przypadku gęstość energia anizotropii indukowanej naprężeniami może być wyznaczona z zależności [13]:

$$K_{\sigma} = \frac{3}{2}\lambda_s\sigma \tag{1}$$

w której  $\lambda_s$  to magnetostrykcja nasycenia materiału, zaś  $\sigma$  – wartość naprężeń. Ponieważ stop amorficzny o sk ładzie Fe<sub>78</sub>Si<sub>13</sub>B<sub>9</sub> w stanie wyj ściowym cechuje si ę m agnetostrykcją oko ło 30 µm/m, należy przypuszczać, że niewielka gęstość energii anizotropii naprężeń  $K_{\sigma}$  wynika z faktu, że naprężenia w łasne wytworzone w czasie produkcji ta śmy amorficznej z czasem uległy, relaksacji.



Rys. 5. P ętle histerezy m agnetycznej B(H) ta śmy ze stopu o sk ładzie Fe $_{78}$ Si<sub>13</sub>B<sub>9</sub> w stanie wyjściowym, mierzone w kierunkach X i Y

Przedstawione na rys. 5 charakterystyki m agnesowania B(H) ta śmy ze stopu o sk ładzie Fe<sub>78</sub>Si<sub>13</sub>B<sub>9</sub> w stanie wyj ściowym dowodzą, że rdzenie z tego m ateriału mogą być wykorzystywane do opracowania czujników transduktorowych do pom iaru pola m agnetycznego w dwóch osiach. Do tej pory czujniki takie nie by ły opracowane, ze wzgl ędu na nies łuszne oczekiwanie silnej anizotropii ta śmy ze stopu o sk ładzie Fe<sub>78</sub>Si<sub>13</sub>B<sub>9</sub>. Nale ży podkre ślić, że poglądy te nie m ogły być do tej pory zweryfikowane eksperym entalnie ze wzgl ędu na brak metodyki pomiaru charakterystyk magnesowania taśm amorficznych w dwóch osiach.

Na rys. 6 przedstawiono charakterystyki przetwarzania opracowanego, dwuosiowego, m iniaturowego czujnika transduktorowego, zróżnicowane ze względu na wartość skuteczną sinusoidalnego przebiegu pr ądu I<sub>z</sub> zasilaj ącego uzwojenie m agnesujące. Analizowanym sygna łem wyjściowym z czujnika jest am plituda drugiej harm onicznej przebiegu zasilaj ącego  $U_{2f}$ , filtrowana z przebiegu uzyskiwanego na uzwojeniu pomiarowym.

Uzyskane wyniki potwierdzaj ą wysok ą czu łość opracowanego czujnika transduktorowego zarówno w osi X, jak i w osi Y, w szerokim zakresie pól m ierzonych  $H_p$ . Ponadto wy ższa czułość uzyskiwana jest dla m niejszych wartości skutecznych prądu zasilającego czujnik, co jest zgodne z oczekiwaniam i i m oże być wykorzystane do redukcji m ocy zasilania niezb ęd-nego do pracy czujnika.



Rys. 6. Charakterystyki przetwarzania opracowanego czujnika transduktorowego zró żnicowane na wartość skuteczną prądu zasilającego  $I_z$ : a) w osi X, b) w osi Y

## 6. PODSUMOWANIE

Przedstawiona w referacie metoda fotolitograficznej produkcji miniaturowych rdzeni z taśmy amorficznej um ożliwia wytwarzanie rdzeni ram kowych ze stopu o sk ładzie Fe <sub>78</sub>Si<sub>13</sub>B<sub>9</sub>. Rdzenie te cechują się gładkimi krawędziami i mogą być wykorzystywane w opracowywaniu różnego typu czujników, nie tylko czujników transduktorowych.

Nowatorska metodyka pomiaru charakterystyk magnesowania ramkowych rdzeni z magnetyków am orficznych um ożliwiła weryfikacj ę pogl ądów odno śnie warto ści g ęstości energii anizotropii w magnetyku amorficznym. Gęstość energii anizotropii ta śmy okazała się na tyle niewielka, że czujniki transduktorowe m ogą pracowa ć zarówno z wykorzystaniem kolum n rdzenia ramkowego w kierunku taśmy, jak i w kierunku prostopadłym do kierunku taśmy.

Opracowane egzem plarze czujników transduktorowych um ożliwiły praktyczną weryfikację ich param etrów funkcjonalnych. Zarówno charakterystyki opracowanych czujników w kierunku X, jak i w kierunku Y cechują się wysoką czułością. Ponadto czułość przetwarzania czujników transduktorowych ro śnie dla m niejszych wartości skutecznych prądu zasilającego czujnik, co m oże być wykorzystane do redukcji m ocy zasilania niezb ędnego do pracy czujnika.

## BIBLIOGRAFIA

- 1. M. G. Drahor, T. Kurtulmus, M. Berge, M. Hartmann M. Speidel "Magnetic imaging and electrical resistivity tom ography studium in a Rom an military installation fund in Satala archeological site, northeastern Anatolia, Turkey" Journal of Archeological Science 35 (2008) 259.
- 2. R. Szewczyk, J. Salach, A. Bie ńkowski, R. K łoda, M. Safinowski "Testing of the three axis magnetometers for m easurements of the earth m agnetic field" Journal of Autom ation, Mobile Robotics and Intelligent Systems 4 (2009) 96.
- 3. P. Ripka, A. M. Lewis, J. Kubik "Min e Detection in Magnetic Soils" Sensor Letters 5 (2007) 15–18.
- 4. S. Tumański "Cienkowarstwowe czujniki m agnetorezystancyjne" Oficyna W ydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
- 5. Z. Dunajski "Biomagnetyzm", WKŁ, Warszawa, 1990.
- 6. D. Gordon, R. Brown, J. Haben "Methods for measuring the magnetic field" IEEE Trans. Magn. 8 (1972) 48.
- 7. P. Ripka "Review of fluxgate sensors" Sensors and Actuators A33 (1992) 129.
- 8. S. Tumański "Czujniki pola m agnetycznego stan obecny i kierunki rozwoju" Przegl ąd Elektrotechniczny 2 (2004) 74.
- 9. P. Ripka "Magnetic Sensors and Magnetometers" Artech 2001.
- 10. R. O'Handley "Modern magnetic materials principles and applications" John W iley & sons, 2000.
- 11. F. Primdahl "The fluxgate mechanism" IEEE Trans. Magn .6 (1970) 376.
- 12. G. Musmann, Y. Afanasiev "Fluxgate magnetometers for space research" BoD, 2010.
- 13. E. Tremolet "Magnetostriction" CRC Press, London, 1992.